

© 1990

ПОВЕРХНОСТНЫЕ ПЛАЗМЕННЫЕ ПОЛЯРИТОНЫ В СРЕДЕ С ПРОСТРАНСТВЕННО-НЕОДНОРОДНЫМ ПЕРЕХОДНЫМ СЛОЕМ

Н. Л. Дмитрук, Ю. В. Крюченко, В. Г. Литовченко

Рассмотрена модель неоднородного приповерхностного переходного слоя с пространственным распределением носителей заряда в виде размытой ступеньки. Определены количество и характер поверхностных плазменных поляритонных мод как при обогащении, так и при истощении приповерхностного слоя. Прослежен генезис дисперсионных ветвей при переходе от экспоненциального к ступенчатому распределению и сделан прогноз относительно степени их проявления в спектрах НРВО.

Практически важным случаем переходных слоев в твердотельной плазме являются приповерхностные области с пространственной неоднородностью диэлектрической проницаемости (ДП) вдоль нормали к поверхности. Примерами могут служить естественные области пространственного заряда (ОПЗ) в полупроводниках, области неоднородного легирования электрически активной примесью (созданные путем диффузии или ионной имплантации). В неравновесном случае характер неоднородного пространственного распределения носителей в приповерхностной области существенно зависит от соотношения диффузионной длины $L_p(z)$, обратного коэффициента поглощения $1/\alpha$ и «длины» поверхностной рекомбинации $s\tau_p$, где s — скорость поверхностной рекомбинации.

Влияние приповерхностной ОПЗ на дисперсию плазменных поверхностных поляритонов (ППП) исследовалось ранее в ряде работ. Были изучены случаи ступенчатого [1], линейного [2] и экспоненциального [3, 4] изменения концентрации носителей заряда в приповерхностной области. Интересной особенностью в случае экспоненциального распределения является возникновение новых экстраординарных дисперсионных ветвей ППП.

В настоящей работе рассмотрена более общая модель, в которой реализуются как ранее исследовавшиеся случаи экспоненциального и ступенчатого распределений $N(z)$, так и различные промежуточные случаи. Это позволило проследить генезис дисперсионных ветвей ППП при плавном переходе от экспоненциального к ступенчатому распределению $N(z)$ и прояснить их физическую природу.

Рассмотрение проведено для ППП TM типа. Напряженности магнитного и электрического поля таких мод удовлетворяют уравнениям Максвелла

$$\frac{d}{dz} \left[\frac{1}{\varepsilon(\omega, z)} \frac{dH_y}{dz} \right] + \left[\frac{\omega^2}{c^2} - \frac{k_x^2}{\varepsilon(\omega, z)} \right] H_y = 0,$$

$$E_x = - \frac{ic}{\omega \varepsilon(\omega, z)} \frac{dH_y}{dz}, \quad E_z = - \frac{ck_x}{\omega \varepsilon(\omega, z)} H_y, \quad (1)$$

где k_x — компонента волнового вектора в плоскости поверхности раздела среда—вакуум. В локальном приближении в области нахождения плазмы ($z < 0$) ДП можно записать в виде

$$\varepsilon(\omega, z) = \varepsilon_\infty [1 - \omega_p^2(z)/\omega^2], \quad (2)$$

$\omega_p^2(z) = 4\pi e^2 N(z)/m^* \varepsilon_\infty$. Будем искать собственные решения (1) для функции распределения $N(z)$ следующего вида:

$$N(z) = N_b + (N_s - N_b) \frac{1 + \exp(l/d)}{1 + \exp((l-z)/d)}, \quad (3)$$

где N_s, N_b — концентрации электронов на поверхности и в объеме; l — величина, описывающая протяженность приповерхностной области; d — постоянная спада $N(z)$ на границе с квазинейтральным объемом (типа длины Дебая в случае ОПЗ). Решения (1) удобно искать методом разложения в ряды в окрестности особых точек. Следуя [4], представим поле H_y в виде $H_y = F(z) \exp(p_0 z)$, где $p_0^2 = k_x^2 - \varepsilon_b \omega^2/c^2$, ε_b — объемное значение ДП среды. Тогда с переходом к новой переменной $v = -\varepsilon(\omega, z)/\varepsilon_b$ уравнение (1) приобретает следующую форму:

$$v(v+1)(v-v_i)^2 \frac{d^2 F}{dv^2} + (v-v_i)(v^2 - 2av_i + v_i) \frac{dF}{dv} + y_i(av - av_i - qvy_i)F = 0, \quad (4)$$

где $\alpha = p_0 d$; $q = \varepsilon_b d^2 \omega^2/c^2$; $y_i = (1 + \exp(l/d))(\omega_{ps}^2 - \omega_{pb}^2)/(\omega^2 - \omega_{pb}^2)$; $v_i = y_i - 1$; ω_{ps}, ω_{pb} — плазменные частоты на поверхности и в объеме кристалла. Данное уравнение имеет три особые точки, причем точка v_i является двукратно вырожденной. В окрестности особой точки $v=0$ два независимых решения (4) могут быть представлены в виде

$$F_{1v} = \sum_{k=2}^{\infty} a_k v^k, \quad F_{2v} = \sum_{k=0}^{\infty} b_k v^k + \ln|v| \sum_{k=2}^{\infty} a_k v^k, \quad (5)$$

в окрестности $v=-1$ физически оправданное затухающее в глубь плазмы решение имеет вид

$$F_y = \sum_{k=0}^{\infty} a_k y^k, \quad (6)$$

где $y=v+1$, а в окрестности $v=v_i$ два независимых решения могут быть записаны следующим образом:

$$F_{jw} = |w|^{\mu_j} \sum_{k=0}^{\infty} a_k^{(j)} w^k, \quad (7)$$

где $j=1, 2$; $\mu_{1(2)} = \alpha \pm (\alpha^2 + qy_i)^{1/2}$; $w = v - v_i$. Радиусы сходимости рядов (5)–(7) $R_v = \min\{1, |v_i|\}$, $R_y = \min\{1, |y_i|\}$ и $R_w = \min\{|v_i|, |y_i|\}$ соответственно.

На кривой $\omega_s(k_x) = (\omega_{ps}^2 + k_x^2 c^2/\varepsilon_\infty)^{1/2}$ имеет место вырождение характеристических корней $\mu_1 = \mu_2$. В этом случае

$$F_{1w} = |w|^\alpha \sum_{k=0}^{\infty} a_k w^k, \\ F_{2w} = |w|^\alpha \ln|w| \sum_{k=0}^{\infty} a_k w^k + |w|^\alpha \sum_{k=1}^{\infty} b_k w^k. \quad (8)$$

В ситуации с неоднородным слоем истощения существует область частот $(\omega_{ps}^2 + k_x^2 c^2/\varepsilon_\infty)^{1/2} < \omega < (\omega_{pb}^2 + k_x^2 c^2/\varepsilon_\infty)^{1/2}$, где характеристические корни μ_1 и μ_2 являются комплексными, причем $\mu_1^* = \mu_2$. В этой области частот две линейно-независимые функции F_{1w} и F_{2w} будут определяться действительной и мнимой частями одного из выражений (7), например, с $j=1$.

Рекуррентные соотношения для нахождения коэффициентов разложения могут быть легко получены подстановкой вышеприведенных рядов в уравнение (4).

Дисперсия поверхностных мод находится из дисперсионного уравнения

$$r_0 + \varepsilon(\omega, 0) \sqrt{k_x^2 - \omega^2/c^2} + F'(v_0)/F(v_0) = 0, \quad (9)$$

где v_0 — значение переменной v на поверхности, штрих у функции F означает ее производную по переменной z . Если при $v=v_0$ ряд (6) является сходящимся, то в качестве F в (9) можно использовать функцию F_y . Однако это возможно лишь в ограниченной области частот. В других частотных областях функция F в (9) выражается через линейные комбинации независимых решений (5) или (7). Поскольку области сходимости рядов (5) — (7) перекрываются, то содержащаяся в отношении F'/F в (9) константа в этом случае выразится через отношение F'_y/F_y в некоторой произвольной точке сшивки в окрестности «объемного» значения $v=-1$.

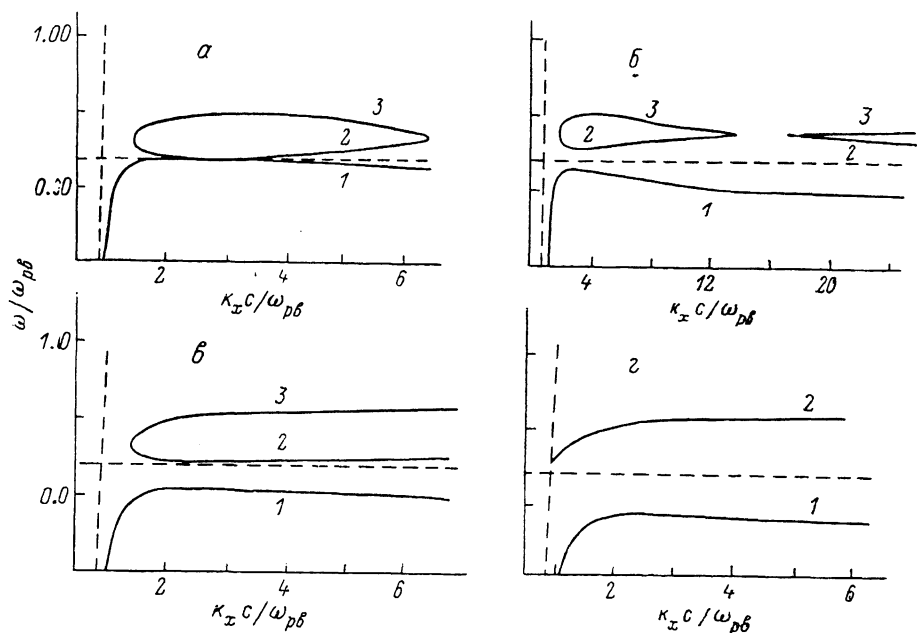


Рис. 1. Дисперсия плазменных поверхностных поляритонов при истощении в случае $\omega_{ps}=0.92 \omega_{pb}$, $d\omega_{pb}/c=0.1$ и $l\omega_{ps}/c=1$ (а), -0.076 (б), -0.25 (в), -0.5 (г).

Численные примеры рассчитаны применительно к параметрам легированного полупроводника InSb. Оказалось, что в общем случае имеет место сложный спектр с дисперсионными петлями, который можно представить тремя ветвями ППП. Физическая природа этих ветвей связана с: 1) поляритонем свободной поверхности плазмы; 2) граничным поляритонем на границе переходного слоя и объема; 3) слабодисперсионным ППП, обусловленным размытием переходной области. Увеличение крутизны диэлектрической ступеньки ускоряет трансформацию спектра ППП, и при достаточно резкой ступеньке остаются лишь две первые моды колебаний в соответствии с [1] (рис. 1, 2). Третья мода в процессе трансформации становится практически бездисперсионной и попадает в окрестность частоты ω_{ps} , где и происходит ее исчезновение, однако полную картину ее исчезновения в рамках данного расчета выяснить затруднительно. Это обусловлено тем, что приведенные разложения могут быть применены для нахождения дисперсии ППП везде, за исключением малой окрестности частоты $\Omega_s = \omega_{ps} (1 + (1 - \omega_{pb}^2/\omega_{ps}^2) \exp(l/d))^{1/2}$, где $v_s \rightarrow 0$. В последнем случае радиусы сходимости рядов R_s и R_ω стремятся к нулю, что не позволяет провести расчет достаточно корректно. Если $\exp(l/d) \ll 1$ (это означает, что размытие практически отсутствует), то $\Omega_s \approx \omega_{ps}$, поэтому «запрещен-

ная» для расчетов область частот оказывается лежащей в узком интервале вокруг частот ω_{ps} .

В предельном случае экспоненциального распределения имеет место переход к известным результатам [4] с обычной и экстраординарной ветвями ППП.

Для пространственного распределения полей всех трех мод ППП характерным является прохождение H_y через максимум в точке, где $\epsilon(z) = 0$, и разрыв в этой точке E_x и E_z (с учетом диссипаций, также, по-видимому, имеющих в этой точке максимумы). В глубь кристалла поля всех трех мод монотонно затухают. Наличие областей резкого возрастания

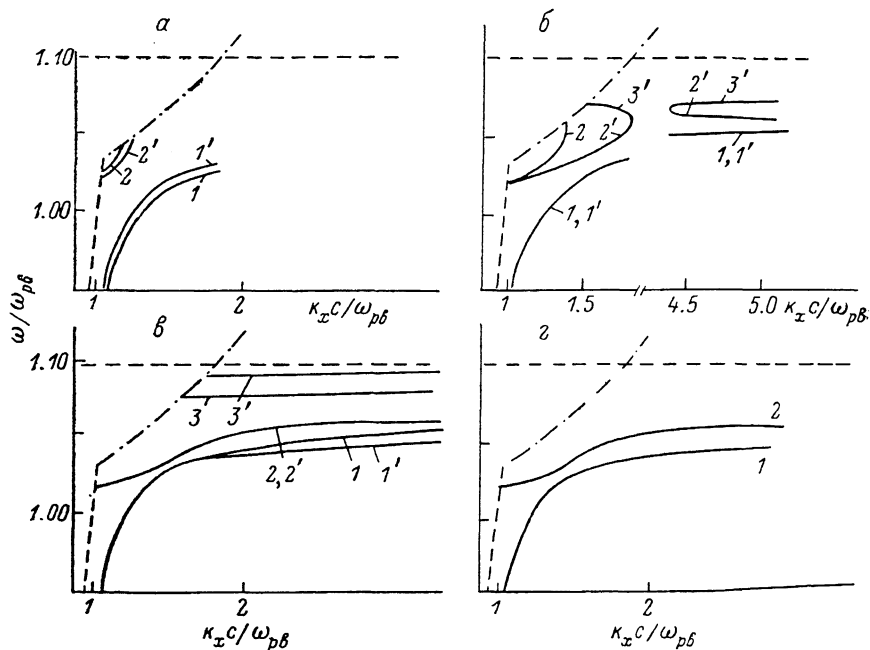


Рис. 2. Дисперсия плазменных поверхностных поляритонов при обогащении в случае $\omega_{ps} = 1.1 \omega_{pb}$, $d\omega_{pb}/c = 1$ (a-б) и 0.1 (а); $l\omega_{pb}/c = 10$ (1, 2) и 1 (1', 2') (a), 0 (1, 2) и -0.7 (1' - 3') (б), -1 (1-3) и -2 (1'-3') (в), -2 (1, 2) (г).

полей в переходном слое может привести к усилению различных оптических эффектов (ИК поглощение, комбинационное рассеяние света, увеличение сечения фотоионизации локальных центров и др.).

Относительный вклад полученных ветвей ППП, например, в экспериментально наблюдаемый спектр НПВО можно оценить по интегральному уменьшению площади под кривой отражения в области соответствующих частот. При большом зазоре (среда 2) между образцом (среда 1) и призмой НПВО (среда 3) $d_2 \gg 1/\chi_2$ и малом затухании в плазме $\Gamma \ll \omega_{pb}$ этот параметр для i -й моды рассчитывается по формуле [5]

$$W_i \approx 16\pi \exp(-2\chi_2 d_2) \left(\frac{\epsilon_2}{\chi_2}\right)^2 \frac{\chi_1}{\epsilon_1} \left[1 + \left(\frac{\epsilon_2 \chi_1}{\epsilon_1 \chi_2}\right)^2\right]^{-1} \times \left| \frac{d}{d\omega} \left[\frac{\epsilon_3(\omega, 0)}{\chi_3 + (F'/F)_{\omega=0}} + \frac{\epsilon_2}{\chi_2} \right]_{\omega=\omega_i} \right|^{-1}, \quad (10)$$

где $\chi_j = (k_x^2 - \epsilon_j \omega^2/c^2)^{1/2}$, ϵ_j — ДП j -й среды (для $j=3$ берется объемное значение ДП ϵ_p). Если затухания поляритонов Γ_i известны, то контраст спектра НПВО (величины провалов на частотах ω_i) можно оценить как $k_{\text{НПВО}} \approx W_i/\Gamma_i$. Численные результаты, полученные при $d_2 \omega_{pb}/c = 0.5$ (для такой величины зазора значение \exp в (10) ~ 0.1), $\epsilon_1 = 30$, $\epsilon_2 = 1$, $\epsilon_\infty = 16$, для: а) слоя истощения с параметрами $\omega_{ps} = 0.92 \omega_{pb}$, $l\omega_{pb}/c = -0.25$,

Оценки параметров спектра НПВО для неоднородных слоев истощения и обогащения

Параметры	Истощение			Обогащение		
	1	2	3	1	2	3
Номер ветви i	1	2	3	1	2	3
ω_i/ω_{pb}	0.903	0.924	0.950	1.045	1.058	1.093
W_i/ω_{pb} , %	0.7	8.9	2.6	4.1	3.0	2.9

$d\omega_{pb}/c=0.1$, $k_x c/\omega=2.1$; б) слои обогащения с параметрами $\omega_{ps}=1.1 \omega_{ps}$, $l\omega_{pb}/c=-2$, $d\omega_{pb}/c=1$, $k_x c/\omega=2.29$ приведены в таблице. Видно, что контраст спектра НПВО на всех трех частотах ППП соизмерим и при $\Gamma/\omega_{pb} \sim 0.1$ может достигать десятков процентов, т. е. может быть легко зафиксирован экспериментально.

Список литературы

- [1] Wallis R. F., Brion J. J., Burstein E., Harstein A. // Proc. Int. Conf. Phys. Semicond. 1972. P. 1448—1454.
- [2] Cunningham L., Maradudin A. A., Wallis R. F. // Phys. Rev. B. 1974. V. 10. N 8. P. 3342—3365.
- [3] Guidotti D., Rice S. A., Lemberg H. L. // Sol. St. Comm. 1974. V. 15. N 2. P. 113—117.
- [4] Kao C., Conwell E. M. // Phys. Rev. B. 1976. V. 14. N 6. P. 2464—2470.
- [5] Агранович В. М., Гинзбург В. Л. Кристаллооптика с учетом пространственной дисперсии и теории экситонов. М., 1979. 432 с.

Институт полупроводников АН УССР
Киев

Поступило в Редакцию
29 июня 1989 г.